

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【公開番号】特開2005-64301(P2005-64301A)

【公開日】平成17年3月10日(2005.3.10)

【年通号数】公開・登録公報2005-010

【出願番号】特願2003-293887(P2003-293887)

【国際特許分類】

H 01 L 21/268 (2006.01)

H 01 L 21/20 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/268 F

H 01 L 21/20

H 01 L 29/78 6 2 7 G

【手続補正書】

【提出日】平成18年8月14日(2006.8.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に半導体膜を形成する工程と、半導体膜を被照射面として、レーザビームを前記被照射面に対して斜めに入射させ、前記レーザビームの位置を相対的に移動させながらレーザアニールする工程とを有し、前記レーザビームに対する被照射面の相対的な移動方向をa、前記レーザビームの入射方向をbとすると、aとbの内積が0未満となるようにすることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

基板に半導体膜を形成する工程と、半導体膜を被照射面として、レーザビームを前記被照射面に対して斜めに入射させ、前記レーザビームの位置を相対的に移動させながらレーザアニールする工程とを有し、前記レーザビームに対する被照射面の相対的な移動方向をa、前記レーザビームの入射方向をbとすると、aとbのなす角度が90度より大きくなるようにすることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1又は2において、前記レーザアニールする工程において、前記レーザビームを被照射面においてエネルギー分布が均一なレーザビームに加工して、前記半導体膜に照射することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか一項において、前記レーザアニールする工程において、前記レーザビームを被照射面において長方形状に加工して、前記半導体膜に照射することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一項において、前記レーザビームの一部は前記半導体膜を透過することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項6】

請求項 1 乃至 5 のいずれか一項において、前記レーザビームは連続発振のレーザ照射器から発振されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0059

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0059】

また、本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図11に示す。なお、図7～図10に対応する部分には同じ符号を用いている。また、図10中の鎖線B-B'は図11中の鎖線B-B'で切断した断面図に対応している。